



「SiC ウェハおよびパワーデバイス用 Si ウェハの現状と課題」

◇ 日時： 2024 年 7 月 2 日 (火) 13:00~17:10

◇ 場所： 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス 学術交流会館 多目的ホール

<https://www.omu.ac.jp/about/campus/nakamozu/>

パワーデバイス用基板として実用化されているSiCウェハならびにパワーデバイス用のSiウェハについて、主要各社からのご講演を通じてその現状を俯瞰するとともに、パワー半導体の国際規格に係るIEC (International Electrotechnical Commission、国際電気標準化会議) 白書の内容にも照らし合わせ、今後の課題等について議論する。

.....プログラム.....

12:30 開場

13:00~13:05 開会挨拶

13:05~13:50 レゾナック社における SiC エピウェハービジネス概要

金澤 博 (株式会社レゾナック デバイスソリューション事業部)

13:50~14:35 パワーデバイス用シリコンウェハの現状

坪田 寛之 (グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 技術部)

14:35~14:50 休憩

14:50~15:35 貼り合わせ基板 SiCkrest の開発

小林 元樹 (株式会社サイコックス 技術部)

15:35~16:20 中国 SiC 基板メーカーTanKeBlue Semiconductor Co.,Ltd について

南 篤朗 (株式会社ニューメタルスエンドケミカルスコーポレーション 電子材料部)

16:20~17:05 IEC 白書「Power Semiconductors for an energy-wise society」紹介

近藤 晴房 (三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所)

17:05~17:10 閉会挨拶

.....

■参加受付: WEB 参加受付システム ([ここをクリック*](#)) から参加登録と参加費のオンライン決済をお願いします。席数に限りがあるため早期に参加受付を終了することがあります。なお、当日の資料は PDF 版となります。

*本案内が印刷物の場合、<http://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai27.pdf> よりアクセスして下さい。

■参加費: (消費税込)

先進パワー半導体分科会会員* 4,000 円、分科会学生会員 無料、一般 6,000 円、一般学生 1,000 円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■現地開催におけるご協力のご願い: 発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。会場でのマスクの着用は任意とします。

問合せ先:

百瀬 賢治 (レゾナック)

e-mail: momose.kenji.xhipm@resonac.com

中川 聡子 (グローバルウェーハズ・ジャパン)

e-mail: Satoko_Nakagawa@sas-globalwafers.co.jp

東脇 正高 (大阪公立大学)

e-mail: higashiwaki@omu.ac.jp

佐野 泰久 (大阪大学)

e-mail: sano@prec.eng.osaka-u.ac.jp

白石 陽子 (応用物理学会事務局)

e-mail: shiraishi@jsap.or.jp